

教員名：佐藤勝昭

Web site <http://home.sato-gallery.com/>e-mail address: [katsuaki.sato@nifty.com](mailto:katsuaki.sato@nifty.com)

## 第 4 回の質問・感想・注文など

- マクスウェル方程式を解くプロセスが、電磁気学・数学のよい復習になったと思います。(N1 君) 誘電率テンソルの実部・虚部の直感的意味がわかりました。(O2 君) 式の意味や変形などを詳しく解説してくださってわかりやすかったです。(T 君) 複素屈折率の 2 つの固有値が、左右円偏光に対応するという物理に対応づけられることはとても興味深いです。(H 君) 複素成分の取り扱いがわかった気がします。(K 君) 複素屈折率の扱いに慣れました。(K 君)
- 復習を授業中にやって時間とられるのはどうなんでしょう？これを読んどけ、みたいなのでも十分なような気がします。資料作るのとどっちが楽か微妙な気がしますが。(O1 君)

A: 昔なら、教員はそのように対応していました。しかし、学部学生が聴講していること、大学院学生も学力が低下していることを考慮すると、これを読んでおけというわけにいかないのです。資料を作るのは、やぶさかでありませんが、復習が必要な人は、資料をあげても読まないのが普通なのです。実際、前のコメント 1 のように、歓迎している人もいるので、我慢してください。

- (3.26') 式の近似が成り立つということは  $\Delta N$  が十分小さいということだと思うのですが、その理由がわかりませんでした。(Y1 君)

A: 理由としては、実際の物質において  $|\Delta N| = |\epsilon_{xy}/\epsilon_{xx}^{1/2}|$  は 1 より 1 衡程度小さいと云うことからです。 $|\epsilon_{xy}|$  は、磁気光学効果の大きな磁性ガーネットでも 0.5 程度のものです。これに対し、 $|\epsilon_{xx}|$  は 10 の程度の大きさです。従って、 $|\Delta N| = |\epsilon_{xy}/\epsilon_{xx}^{1/2}|$  は 0.1 の程度です。

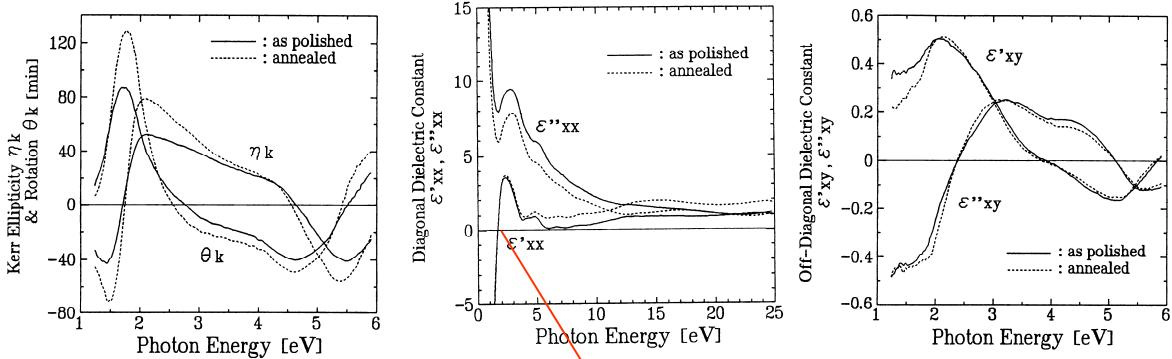
- $\frac{\partial D}{\partial t} + J = \epsilon_0 \frac{\partial E}{\partial t} + \frac{\partial P}{\partial t} + J = \epsilon_0 \frac{\partial E}{\partial t} + J'$  という話がありました。置いてもいいと思うし、純粋に

$J = oE$  と置いてもいいと思うのですが、つまり、J の取り方は、分極電流を含める、真空中変位電流を含める、純粋に電流のみとする、としていずれで解析しても、種々の現象の結果は同じものが得られるのでしょうか。(M 君)

A: あまり深く考える必要がありません。J をすべて変位電流の中に繰り込めば、誘電率で議論できるし、変位電流を J に繰り込めば、導電率で議論できます。誘電率も導電率も複素数で考えれば、全ての現象を記述できます。

- 複素ファラデー回転角  $\Phi_F = -\frac{\omega}{2c} \cdot \frac{i\epsilon_{xy}}{\sqrt{\epsilon_{xx}}} \zeta$ 、複素カーラー回転角  $\Phi_K = \frac{n_0 \epsilon_{xy}}{(n_0^2 - \epsilon_{xx}) \sqrt{\epsilon_{xx}}}$  において、誘電率テンソルの対角成分を小さくする方が、ファラデー回転や橋円率が大きくなるとおっしゃっていましたが、もう少し詳しく聞きたいです。(具体的に)。理想的には  $\Phi$  は発散することもあり得るのですか。(もぐり受講 O 君)

A: 実例は、本日話します。誘電率には虚数部があるので、純粋に発散することはできません。



出典: K.Sato et al: Proc. ICF6 (1992) p.1647

プラズマ振動数:誘電率の実数部がゼロを横切る

- ファラデー効果の式を表す部分がよくわからなかった。(4年 S 君)

A: じっくりと式をフォローしてください。

- 配付資料は、 $E_{out} = E_0 \exp \left\{ -i\omega \left( t - \frac{N}{c} \zeta \right) \right\} \left\{ i' - i \left( \frac{\omega \Delta \kappa}{2c} \zeta \right) j' \right\}$  は、回転した座標系での円偏光であると考えてよいのですか。

(4 年 K2 君)

A: x 軸と y 軸の長さが異なるので、橋円偏光です。

- コットンムートン効果は 2 次の効果で非常に小さいうですが、導波路型の光アイソレータに実用化されているのが驚きました。NiFe で測ったことがあります、小さくて測れませんでした。(U 君)

A: パーマロイは、磁気光学効果が非常に小さいようです。

- ファラデー効果などの磁気光学効果を量子力学から導く手法を学びたいと思いました。(K3 君)

A: シラバスにありますように第 7 回で量子論をやります。

## 第5回で学ぶこと

### 復習コーナー 第4回に学んだこと

#### 物性物理学特論A

- 第5回 電磁気学に基づく磁気光学の理論(3)  
反射の磁気光学効果 -

佐藤 勝昭  
慶應義塾大学講師(非常勤)  
東京農工大学名誉教授・工学府特任教授  
(独)科学技術振興機構(JST)戦略的創造研究事業さきがけ  
「革新的次世代デバイスを目指す材料とプロセス」研究総括

- 光の伝搬をマクスウェルの方程式で記述すると、磁化された等方性物質の複素屈折率 $N_{\pm}^2$ は $\epsilon_{xx\pm i\epsilon_{xy}}$ で与えられる2つの固有値をとり、それぞれが右円偏光および左円偏光に対応することを学びました。そして、 $\epsilon_{xy}$ が0であれば、円偏光は固有関数ではなく、磁気光学効果は生じないことも学びました。
- 磁性体におけるファラデー回転角 $\Phi$ およびファラデー橋円率 $\eta_F$ は、左右円偏光に対する屈折率の差 $\Delta n$ および消光係数の差 $\Delta \kappa$ を用いて表すことができる学びました。
- さらに、ファラデー回転角と橋円率は誘電率テンソルの非対角成分の実数部と虚数部の線形結合で表されることがわかりました。
- ファラデー回転角とファラデー橋円率をそれぞれ実数部、虚数部とする複素ファラデー回転 $\Phi_F$ は、誘電率テンソルの非対角成分 $\epsilon_{xy}$ に比例し、対角成分 $\epsilon_{xx}$ の平方根に反比例することを学びました。

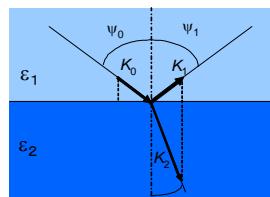
### 第5回に学ぶこと: 光と磁気第3章3.5、3.6

- 今回は、光が物質の表面で反射されたとき、光の強度、位相がどのような変化を受けるかを学びます。
- はじめに斜め入射の場合の反射の法則を導きます。
  - 電界に対する反射率を複素振幅反射率(Fresnel係数)と呼びますが、これがp偏光(振動面が入射面内にある偏光)とs偏光(振動面が入射面と垂直であるような偏光)に対してどのように異なるかを導きます。
- ついで、偏光が磁化をもつ物質で反射されたときの磁気光学効果(磁気力一効果MOKE)について、誘電率テンソルを使って記述します。

### スネルの法則ー波動ベクトルの連続性ー

- 入射光、反射光、屈折光の波数ベクトルをそれぞれ $K_0$ 、 $K_1$ 、 $K_2$ とすると、各媒質におけるマクスウェルの方程式を解いて、波数ベクトルの絶対値に成立り立つの関係式を得ます。

$$\begin{aligned} K_0 &= \frac{\omega}{c} \hat{N}_1 = \frac{\omega}{c} |\sqrt{\epsilon_1}| \\ K_1 &= \frac{\omega}{c} \hat{N}_1 = \frac{\omega}{c} |\sqrt{\epsilon_1}| \\ K_2 &= \frac{\omega}{c} \hat{N}_2 = \frac{\omega}{c} |\sqrt{\epsilon_2}| \end{aligned} \quad (3.59)$$

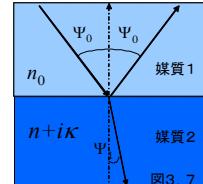


マクスウェル方程式の固有解  
 $\epsilon_1 = N_1^2 \quad \epsilon_2 = N_2^2$

### 光の反射

- 図3.7のように媒質1から媒質2に向かって、平面波の光が入射するときの反射と屈折を考える。両媒質は均質であり、媒質1の屈折率は $n$ で、消光係数は0、媒質2の屈折率は $n+i\kappa$ で、消光係数は $\kappa$ であるとする。また、それぞれの媒質の誘電率を $\epsilon_1$ 、 $\epsilon_2$ とする。従って、媒質1においては

$$\epsilon_1 = n_0^2 \quad \text{が、媒質2においては} \quad \epsilon_2 = (n+i\kappa)^2$$



境界面から媒質2の中に向かう法線方向をz軸にとります。光の入射面はxz面内にあるとします。入射光と法線のなす角(入射角)をPsi\_0、反射光の法線となす角をPsi\_1、媒質2へと屈折する光の法線となす角をPsi\_2とします。

### スネルの法則

- 境界面内での波数ベクトルの各成分の連続性から、x成分については

$$K_{0x} = K_{1x} = K_{2x} \quad (3.60)$$

が成立します。従って

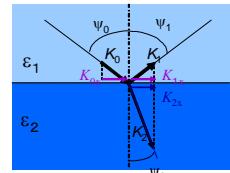
$$K_0 \sin \psi_0 = K_1 \sin \psi_1 = K_2 \sin \psi_2$$

これより

$$\frac{\sin \psi_2}{\sin \psi_0} = \frac{K_0}{K_2} = \sqrt{\frac{\epsilon_1}{\epsilon_2}} = \frac{\hat{N}_1}{\hat{N}_2} \quad (3.61)$$

\*この第2式はいわゆるスネルの法則です。

ただし、複素数に拡張されています。



$$\begin{aligned} K_{1z} &= -K_{0z} = -K_0 \cos \psi_0 = -\frac{\omega}{c} \sqrt{\epsilon_1} \cos \psi_0 \\ K_{2z} &= \sqrt{K_1^2 - K_{1z}^2} = \sqrt{K_1^2 - K_{0z}^2} = \sqrt{K_1^2 - K_0^2 \sin^2 \psi_0} \\ &= \frac{\omega}{c} \sqrt{\epsilon_2 - \epsilon_1 \sin^2 \psi_0} \end{aligned} \quad (3.62)$$

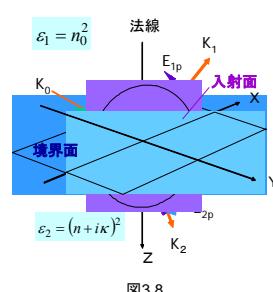
### 斜め入射のフレネル係数を求める

- 媒体どうしの界面で反射が起きます。
- 境界条件のもとにマクスウェルの方程式を解いて入射光の電界と反射光の電界を求めます。
- p偏光、s偏光の反射の際の振幅・位相変化は入射角に依存します。複素振幅反射率をフレネル係数といいます。
- p偏光、s偏光の振幅反射率の比と位相差を使うと、光学定数が導かれます。

### 斜め入射の場合の反射

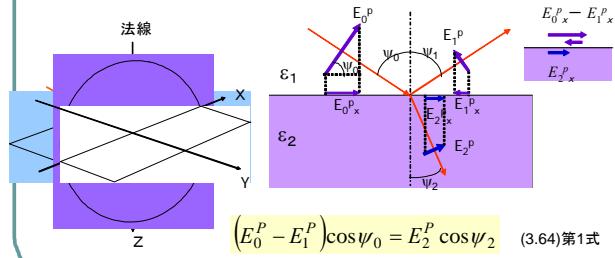
- 図3.8において、入射面(入射光と法線を含む面)をxzとしたとき、この面に垂直な電界ベクトルの成分(y成分)を $E^P$ のように垂直を意味するドイツ語senkrechtの頭文字のSをつけて表し、入射面内の成分を $E^P$ のようにP(parallel)をつけて表します。入射側には下付の添え字0をつける。反射光には1、屈折光には2をつける。x成分、y成分をP成分、S成分を使って表しますと

$$\begin{aligned} E_{0x} &= E_0^P \cos \psi_0, E_{0y} = E_0^S \\ E_{1x} &= -E_1^P \cos \psi_0, E_{1y} = E_1^S \\ E_{2x} &= E_2^P \cos \psi_2, E_{2y} = E_2^S \end{aligned} \quad (3.63)$$



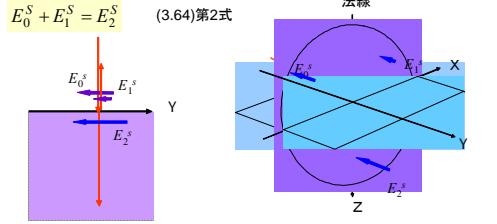
## 電界・磁界の界面における連続性(1)

- 界面における電界p成分の連続性により



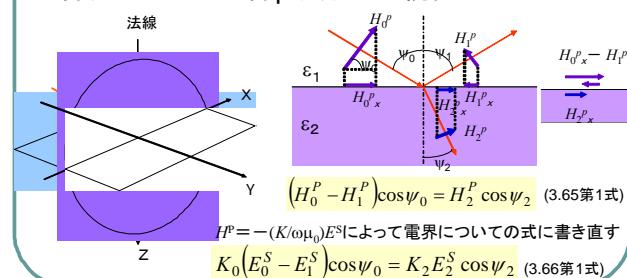
## 電界・磁界の界面における連続性(2)

- 界面における電界s成分の連続性は次式で表されます。



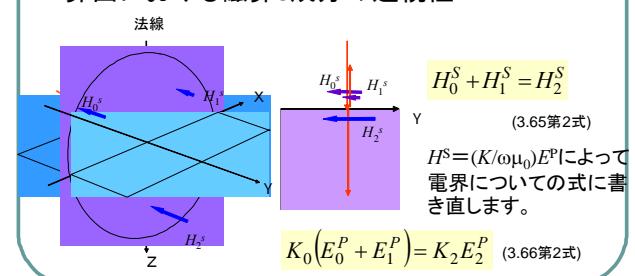
## 電界・磁界の界面における連続性(3)

- 界面における磁界p成分の連続性



## 電界・磁界の界面における連続性(4)

- 界面における磁界s成分の連続性



## 電界と磁界の界面における連続性(5)

$$(E_0^P - E_1^P) \cos \psi_0 = E_2^P \cos \psi_2 \quad (3.64)$$

$$E_0^S + E_1^S = E_2^S$$

$$K_0(E_0^S - E_1^S) \cos \psi_0 = K_2 E_2^S \cos \psi_2 \quad (3.66)$$

$$K_0(E_0^P + E_1^P) = K_2 E_2^P$$

$$\bullet E_2^P \text{を消去} \quad (K_2 \cos \psi_0 - K_0 \cos \psi_2)E_0^P + (K_2 \cos \psi_0 + K_0 \cos \psi_2)E_1^P = 0$$

$$\bullet E_2^S \text{を消去} \quad (K_2 \cos \psi_2 + K_0 \cos \psi_0)E_0^S + (K_2 \cos \psi_2 - K_0 \cos \psi_0)E_1^S = 0$$

連立方程式を解く

## 複素振幅反射率(Fresnel係数)

$$\begin{aligned} \text{Fresnel係数} \\ P\text{偏光の反射} & \rightarrow r_p = \frac{E_1^P}{E_0^P} = \frac{K_2 \cos \psi_0 - K_0 \cos \psi_2}{K_2 \cos \psi_0 + K_0 \cos \psi_2} \\ &= \frac{K_2^2 \cos \psi_0 - K_0^2 \sqrt{K_2^2 - K_0^2 \sin^2 \psi_0}}{K_2^2 \cos \psi_0 + K_0^2 \sqrt{K_2^2 - K_0^2 \sin^2 \psi_0}} = \tan(\psi_0 - \psi_2) \\ S\text{偏光の反射} & \rightarrow r_s = \frac{E_1^S}{E_0^S} = \frac{K_0 \cos \psi_0 - K_2 \cos \psi_2}{K_0 \cos \psi_0 + K_2 \cos \psi_2} \\ &= \frac{K_0 \cos \psi_0 - \sqrt{K_2^2 - K_0^2 \sin^2 \psi_0}}{K_0 \cos \psi_0 + \sqrt{K_2^2 - K_0^2 \sin^2 \psi_0}} = -\frac{\sin(\psi_0 - \psi_2)}{\sin(\psi_0 + \psi_2)} \end{aligned} \quad (3.67)$$

ここに、 $r_p = |r_p| e^{i\phi_p}$ 、 $r_s = |r_s| e^{i\phi_s}$ です。

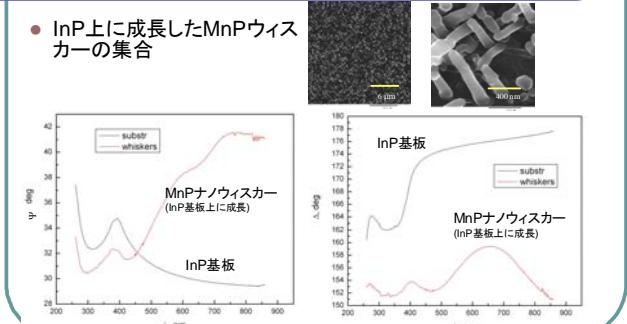
## エリプソメトリ(偏光解析)

$$\frac{r_s}{r_p} = -\frac{\cos(\psi_0 - \psi_2)}{\cos(\psi_0 + \psi_2)} = \left| \frac{r_s}{r_p} \right| \exp(i\delta) \equiv \tan \rho \exp(i\delta) \quad (3.68)$$

- ρ azimuth (方位角)(ψと書くことも)
- δ phase (位相差) (Δと書くことも)
- 反射は方位角ρと位相差δ-δp-δsによって記述できます。
- 反射光は一般には橙円偏光になっていますが、そのp成分とs成分の逆正接角ρと位相差δを測定すればδが求められます。(測定には1/4波長板と回転検光子を用います。)この方法を偏光解析またはエリプソメトリといいます。

## 分光エリプソメトリのデータ例

- InP上に成長したMnP whiskerの集合

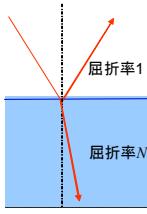


## P偏光反射率とS偏光反射率

- 光強度についての反射率 $R$ は $|r|^2$ で与えられます。第1の媒体が真空、第2の媒体の複素屈折率が $N$ の場合、

$$R_p = \left| \frac{\hat{N}^2 \cos \psi_0 - \sqrt{\hat{N}^2 - \sin^2 \psi_0}}{\hat{N}^2 \cos \psi_0 + \sqrt{\hat{N}^2 - \sin^2 \psi_0}} \right|^2 \quad (3.70)$$

(3.70)

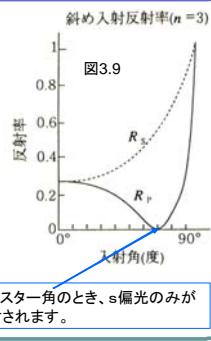
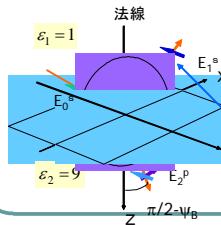


屈折率 $N$

$$R_s = \left| \frac{\cos \psi_0 - \sqrt{\hat{N}^2 - \sin^2 \psi_0}}{\cos \psi_0 + \sqrt{\hat{N}^2 - \sin^2 \psi_0}} \right|^2$$

## 入射角に依存する反射率

- 式(3.69)にもとづいて $N=3+i0$ の場合について、 $R_p, R_s$ をプロットすると図3.9のようにになります。
- $R_p$ は入射角 $70^\circ$ 付近で0となっていることがわかります。この入射角をブリュースター角と呼びます。



### 自習課題

(今回提出の必要はありませんが、ぜひやってみてください)

- 式(3.70)にもとづき、 $N=2.5+i1.0$ の場合の $R_p, R_s$ の入射角依存性を計算して図3.9のようなグラフを描いてください。 $R_p, R_s$ はそれぞれP偏光、S偏光に対する光強度の反射率です。

$$R_p = \left| \frac{\hat{N}^2 \cos \psi_0 - \sqrt{\hat{N}^2 - \sin^2 \psi_0}}{\hat{N}^2 \cos \psi_0 + \sqrt{\hat{N}^2 - \sin^2 \psi_0}} \right|^2$$

(3.70)

$$R_s = \left| \frac{\cos \psi_0 - \sqrt{\hat{N}^2 - \sin^2 \psi_0}}{\cos \psi_0 + \sqrt{\hat{N}^2 - \sin^2 \psi_0}} \right|^2$$

### 知ってますか？エクセルで複素演算ができることを？

- 複素演算を使うには、分析ツールをONにしておかなければなりません。
- 複素数については、通常の $\pm, *, /$ などが使えません。
  - 加算はIMSUM, 減算はIMSUB, 積算はIMPRODUCT, 除算はIMDIVを使います。
  - たとえば、セルG1に実数部が、セルH1に虚数部があったとき、この複素数はCOMPLEX(G1,H1)と表します。
  - 虚数単位iはCOMPLEX(0,1)と表します。
  - 複素数の指数関数はIMEXPという関数を使います。

## 反射と偏光:Brewster角

$$R_p = \left| \frac{\tan(\psi_0 - \psi_2)}{\tan(\psi_0 + \psi_2)} \right|^2 \quad (3.69)$$

$$R_s = \left| \frac{\sin(\psi_0 - \psi_2)}{\sin(\psi_0 + \psi_2)} \right|^2$$

- もし、 $\psi_0 + \psi_2 = \pi/2$ であれば、 $\tan$ が発散するため、 $R_p$ は0となります。
- このとき、反射光はS偏光のみとなります。
- このときの入射角をBrewster angle(ブリュースター角)といいます。

## 垂直入射のFresnel係数

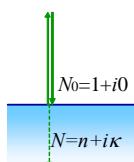
- 垂直入射の場合、 $\psi_0=0$ 、従って $\psi_i=0$ 。このとき電界に対する Fresnel係数 $r$ として、

$$\hat{r} = \hat{r}_p = \frac{K_2 - K_0}{K_2 + K_0} = \frac{N_2 - N_0}{N_2 + N_0} = \frac{\sqrt{\epsilon_2} - \sqrt{\epsilon_1}}{\sqrt{\epsilon_2} + \sqrt{\epsilon_1}} \quad (3.70)$$

を得ます。これより、媒質1が真空( $N_0=1+i0$ )のとき

$$r = \frac{N-1}{N+1} = \frac{n+i\kappa-1}{n+i\kappa+1} \equiv \sqrt{R} \exp(i\theta)$$

を得ます。



## 垂直入射の光強度反射率と位相

- $R=r^*r=|r|^2$ は光強度の反射率、 $\theta$ は反射の際の位相のずれを表します。

$$R = \frac{(1-n)^2 + \kappa^2}{(1+n)^2 + \kappa^2} \quad (3.73)$$

$$n = \frac{1-R}{1+R-2\sqrt{R} \cos \theta}$$

$$\theta = \tan^{-1} \frac{-2\kappa}{n^2 + \kappa^2 - 1^2} \quad \text{逆に解いて} \quad \kappa = \frac{2\sqrt{R} \sin \theta}{1+R-2\sqrt{R} \cos \theta} \quad (3.74)$$

$$R \text{を誘電率で表すと } R = \left| \frac{\sqrt{\epsilon_2} - 1}{\sqrt{\epsilon_2} + 1} \right|^2 \quad (3.73')$$

## 反射率と位相

- 位相のずれは、反射スペクトルからKramers-Kronig(クラマースクローニヒ)の関係を使って求めることができます。

$$\theta(\omega) = \frac{\omega}{\pi} P \int_0^\infty \frac{\ln R(\omega')}{\omega'^2 - \omega^2} d\omega' \quad (3.77)$$

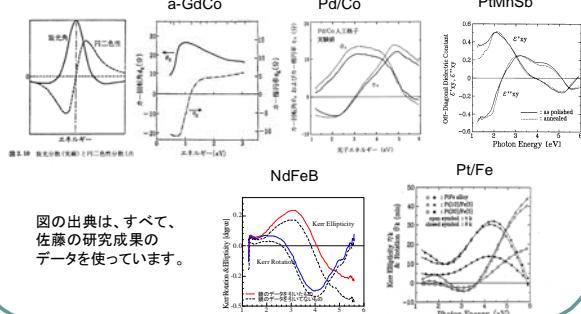
## Kramers-Kronig の関係

- 応答を表す物理量の実数部と虚数部の間に成立 ( $P$ は積分の主値を表す。)

$$\begin{aligned}\epsilon'_{ij}(\omega) &= 1 + \frac{2}{\pi} P \int_0^\infty \frac{\omega' \epsilon''_{ij}(\omega')}{\omega'^2 - \omega^2} d\omega' \\ \epsilon''_{ij}(\omega) &= -\frac{2\omega}{\pi} P \int_0^\infty \frac{\epsilon'_{ij}(\omega')}{\omega'^2 - \omega^2} d\omega'\end{aligned}\quad (3.75)$$

$$P \int_0^\infty \frac{f(\omega')}{\omega'^2 - \omega^2} d\omega' = \lim_{\rho \rightarrow 0} \int_0^{\omega-\rho} \frac{f(\omega')}{\omega'^2 - \omega^2} d\omega' + \lim_{\rho \rightarrow 0} \int_{\omega+\rho}^\infty \frac{f(\omega')}{\omega'^2 - \omega^2} d\omega'$$

## KK変換の微分性(磁気光学)



## つづき

- $f(\omega) = f'(\omega) + if''(\omega)$ を代入し、両辺の実数部、虚数部がそれぞれ等しいことによって導くことができる。
- $\omega$ の複素平面の上半面内で正則、かつ、上半平面で  $|\omega| \rightarrow \infty$ において  $|f(\omega)| \rightarrow 0$ という条件は、 $t=0$ において外場が加えられたときの応答は  $\omega=0$ におけるという因果律に対応している。

$$\begin{aligned}P \int_0^\infty \frac{f(\omega')}{\omega' - \omega} d\omega' &= -\pi i f(\omega) \quad P \int_{-\infty}^0 \frac{f'(\omega') + if''(\omega')}{\omega' - \omega} d\omega' = \pi (f'(\omega) + if''(\omega)) = -\pi (f''(\omega) - if'(\omega)) \\ -\pi i f'(\omega) &= P \int_{-\infty}^0 \frac{f'(\omega')}{\omega' - \omega} d\omega' = P_0^0 \frac{f'(\omega)}{\omega' - \omega} d\omega' + P_0^\infty \frac{f'(\omega')}{\omega' - \omega} d\omega' = P_0^0 \frac{f'(-\omega')}{\omega' - \omega} d(-\omega') + P_0^\infty \frac{f'(\omega')}{\omega' - \omega} d\omega' \\ &= -P_0^0 \frac{f'(\omega')}{\omega' + \omega} d\omega' + P_0^\infty \frac{f'(\omega')}{\omega' - \omega} d\omega' = 2\omega P_0^0 \frac{f'(\omega')}{\omega'^2 - \omega^2} d\omega'.\end{aligned}$$

$\Rightarrow f''(\omega) = -\frac{2\omega}{\pi} P \int_0^\infty \frac{f'(\omega')}{\omega'^2 - \omega^2} d\omega'$

## 磁気光学Kerr効果

- 反射の磁気光学効果を磁気光学力一効果 (MOKE)といいます。
- 右回り円偏光に対するFresnel係数と左回り円偏光に対するFresnel係数の差を考えます。
  - 位相の差からKerr回転角が導かれます。
  - 振幅の差からKerr 楕円率が導かれます。

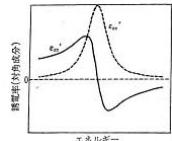
## KK変換の微分性

- 第2式を部分積分すると

$$\epsilon''_{ij}(\omega) = -\frac{1}{\pi} \ln \left| \frac{\omega - \omega'}{\omega + \omega'} \right| \epsilon'_{ij}(\omega') \Big|_0^\infty + \frac{1}{\pi} P \int_0^\infty \ln \left| \frac{\omega - \omega'}{\omega + \omega'} \right| \frac{d\epsilon'_{ij}(\omega')}{d\omega'} d\omega' \quad (3.76)$$

右辺の第1項は0であるから、結局第2項のみとなる。非積分関数は  $\omega \sim \omega'$  付近で大きい値をとるので、 $\epsilon''$  は  $\epsilon'$  の微分形に近いスペクトル形状を示すことになる。

- $\epsilon$  がピークを持つ  $\omega$  では  $\epsilon''$  は急激に変化し、 $\epsilon'$  が急激に変化する  $\omega$  付近で  $\epsilon''$  は極大(または極小)を示す。



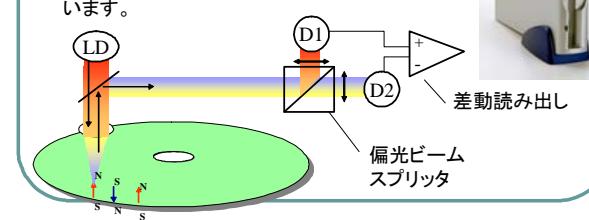
## K-K関係の数学的説明

- 線形応答関数  $f(\omega)$  が、図に示す  $\omega$  の複素平面の上半面内で正則、かつ上半平面で  $|\omega| \rightarrow \infty$ において  $|f(\omega)| \rightarrow 0$ 、さらに実数  $\omega$  に対し  $f'(-\omega) = f(\omega)$ ,  $f''(-\omega) = -f''(\omega)$  であるような性質を持つればよい。このような条件が成り立つとき、コーシーの積分公式によって  $\pi i f(\omega) = \oint d\omega' (\omega' - \omega)^{-1} f(\omega')$  が成立します。

$$\begin{aligned} \oint d\omega' \frac{f(\omega')}{\omega' - \omega} &= 0 \\ \lim_{r \rightarrow 0} \int_{-\infty}^{\omega-r} \frac{f(\omega')}{\omega' - \omega} d\omega' + \lim_{r \rightarrow 0} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} i f(\omega + re^{i\theta}) d\theta \\ + \lim_{r \rightarrow 0} \int_{\omega+r}^{\infty} \frac{f(\omega')}{\omega' - \omega} d\omega' + \lim_{R \rightarrow \infty} \int_{\pi/2}^{-\pi/2} i f(R e^{i\theta}) d\theta &= 0 \\ \int_{-\infty}^{\infty} \frac{f(\omega')}{\omega' - \omega} d\omega' - \pi i f(\omega) &= 0 \end{aligned}$$

## MOディスクの読み出しに使われる力一効果

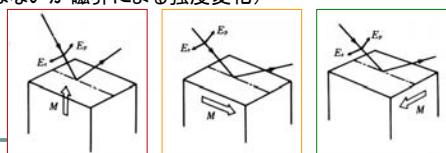
- MOディスクやMDでは、磁気ディスクで反射した偏光の回転を電気信号に変えて磁気情報を読み出しています。



## 3種類の磁気力一効果

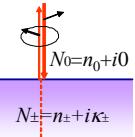
- MO-Kerr効果には、3種類があります。

- 極力一効果**(磁化が反射面の法線方向、直線偏光は傾いた楕円偏光となる)
- 縦力一効果**(磁化が試料面内 & 入射面内、直線偏光は傾いた楕円偏光となる)
- 横力一効果**(磁化が試料面内、入射面に垂直偏光の回転はないが磁界による強度変化)



## 垂直入射の場合の極力一効果

- 問題を複雑にしないために、**極力一効果**の場合を扱い、しかも入射光は界面に垂直に入射するものとします。
- 極力一効果は直線偏光が入射したとき、反射光が橜円偏光となり、その橜円の長軸の向きが入射光の偏光方向に対して回転する現象です。
- この回転をカ一回転角 $\theta_K$ で表し、橜円の長軸と短軸の比を橜円率 $\eta_K$ で表します。
- カ一回転角は右円偏光と左円偏光に対する移相量の差に対応し、橜円率は左右円偏光に対する反射率の違いから生じることを示すことができます。



## Kerr効果

- 右円偏光および左円偏光に対する垂直振幅反射率は

$$\hat{r}_{\pm} = \frac{N_{\pm} - n_0}{N_{\pm} + n_0} \quad (3.78)$$

によって表すことができます(ここに $n_0$ は入射側媒体の屈折率です)。複素振幅反射率(フレネル係数)を右円偏光に対して $r_+ \exp(i\theta_+)$ 、左円偏光にして $r_- \exp(i\theta_-)$ とすると、カ一回転角 $\phi_K$ は

$$\phi_K = \frac{\theta_+ - \theta_-}{2} = \frac{\Delta\theta}{2} \quad (3.79)$$

で与えられます。また、カ一橜円率 $\eta_K$ は次式で与えられます。

$$\eta_K = -\frac{|r_+| - |r_-|}{|r_+| + |r_-|} = -\frac{1}{2} \frac{\Delta r}{r} = -\frac{1}{4} \frac{\Delta R}{R} \quad (3.80)$$

## 複素力一回転

- 磁気力一回転角 $\phi_K$ と磁気力一橜円率 $\eta_K$ をひとまとめにした複素力一回転 $\Phi_K$ を考えます。

$$\begin{aligned} \Phi_K &= \phi_K + i\eta_K = \frac{\Delta\theta}{2} - i\frac{\Delta r}{2r} = -i\frac{1}{2} \left( \frac{\Delta r}{r} + i\Delta\theta \right) \\ \hat{r} &= re^{i\theta} \\ \Delta\hat{r} &= \Delta r e^{i\theta} + ir e^{i\theta} \Delta\theta \\ \frac{\Delta\hat{r}}{\hat{r}} &= \frac{\Delta r e^{i\theta} + ir e^{i\theta} \Delta\theta}{re^{i\theta}} = \frac{\Delta r}{r} + i\Delta\theta \\ \Phi_K &= -i\frac{\Delta\hat{r}}{2\hat{r}} \approx i\frac{1}{2} \ln \left( 1 - \frac{\Delta\hat{r}}{\hat{r}} \right) \approx i\frac{1}{2} \ln \left( \frac{1 - \Delta\hat{r}/2\hat{r}}{1 + \Delta\hat{r}/2\hat{r}} \right) = i\frac{1}{2} \ln \left( \frac{\hat{r}_-}{\hat{r}_+} \right) \end{aligned} \quad (3.81)$$

## 式(3.82)の誘導

- $r_{\pm}$ を $N_{\pm}$ を使って表し、 $N_{\pm}$ に $\epsilon_{xx} \pm i\epsilon_{xy}$ を代入すると、
- $$\begin{aligned} \hat{r}_{\pm} &= \frac{N_{\pm} - n_0}{N_{\pm} + n_0} = \frac{\sqrt{\epsilon_{xx} \pm i\epsilon_{xy}} - n_0}{\sqrt{\epsilon_{xx} \pm i\epsilon_{xy}} + n_0} \approx \frac{\sqrt{\epsilon_{xx}} (\pm i\epsilon_{xy}/\epsilon_{xx}) - n_0}{\sqrt{\epsilon_{xx}} (\pm i\epsilon_{xy}/\epsilon_{xx}) + n_0} = \frac{\sqrt{\epsilon_{xx}} (\pm i\epsilon_{xy}/2\epsilon_{xx}) - n_0}{\sqrt{\epsilon_{xx}} (\pm i\epsilon_{xy}/2\epsilon_{xx}) + n_0} \\ &= \frac{\sqrt{\epsilon_{xx}} - n_0 \pm i\epsilon_{xy}/2\sqrt{\epsilon_{xx}}}{\sqrt{\epsilon_{xx}} + n_0 \pm i\epsilon_{xy}/2\sqrt{\epsilon_{xx}}} = \frac{\sqrt{\epsilon_{xx}} - n_0}{\sqrt{\epsilon_{xx}} + n_0} \frac{1 \pm i\epsilon_{xy}/2\sqrt{\epsilon_{xx}}}{\sqrt{\epsilon_{xx}}/\sqrt{\epsilon_{xx}} + n_0/\sqrt{\epsilon_{xx}}} \approx \hat{r} \left( 1 \mp \frac{i n_0 \epsilon_{xy}}{\sqrt{\epsilon_{xx}} (n_0^2 - \epsilon_{xx})} \right) \end{aligned}$$
- (ここで、 $\hat{r} = (\sqrt{\epsilon_{xx}} - n_0)/(\sqrt{\epsilon_{xx}} + n_0)$ は、偏光を考えないときのフレネル係数です)
- が得られますから、式(3.81)に代入すると式(3.82)となります。
- $$\Phi_K = i\frac{1}{2} \ln \left( \frac{\hat{r}_-}{\hat{r}_+} \right) = i\frac{1}{2} \ln \left( \frac{\hat{r} \left( 1 + \frac{i n_0 \epsilon_{xy}}{\sqrt{\epsilon_{xx}} (n_0^2 - \epsilon_{xx})} \right)}{\hat{r} \left( 1 - \frac{i n_0 \epsilon_{xy}}{\sqrt{\epsilon_{xx}} (n_0^2 - \epsilon_{xx})} \right)} \right) \approx i\frac{1}{2} \ln \left( 1 + \frac{i 2 n_0 \epsilon_{xy}}{\sqrt{\epsilon_{xx}} (n_0^2 - \epsilon_{xx})} \right) \approx \frac{n_0 \epsilon_{xy}}{\sqrt{\epsilon_{xx}} (n_0^2 - \epsilon_{xx})} \quad (3.82)$$

## 複素力一回転を誘電率で表す(2)

- この式の対角成分 $\epsilon_{xx}$ を光学定数 $n, \kappa$ によって表すと、

$$\epsilon_{xx} = \epsilon'_{xx} + i\epsilon''_{xx} = (n^2 - \kappa^2) + i2n\kappa$$

と書けますから、(3.81)に代入して整理することによって、次のような面倒な式を得ます。

$$\theta_K = n_0 \frac{n(n_0^2 - n^2 + 3\kappa^2)\epsilon'_{xy} + \kappa(n_0^2 - 3n^2 + \kappa^2)\epsilon''_{xy}}{(n^2 + \kappa^2)(n_0^2 - n^2 - \kappa^2)^2 + 4\kappa^2} \quad (3.83)$$

$$\eta_K = n_0 \frac{-\kappa(n_0^2 - 3n^2 + \kappa^2)\epsilon'_{xy} + n(n_0^2 - n^2 + 3\kappa^2)\epsilon''_{xy}}{(n^2 + \kappa^2)(n_0^2 - n^2 - \kappa^2)^2 + 4\kappa^2}$$

カ一回転角・橜円率は $\epsilon'_{xy}$ と $\epsilon''_{xy}$ の1次結合で表される。

## 複素力一回転を誘電率で表す(1)

- 結果を先に述べておくと、式(3.81)と式(3.77)とから、次式を得ます。

$$\Phi_K \approx \frac{n_0 \epsilon_{xy}}{(n_0^2 - \epsilon_{xx}) \sqrt{\epsilon_{xx}}} \quad (3.82)$$

この式は、カ一効果が誘電率の非対角成分 $\epsilon_{xy}$ に依存するばかりでなく、分母に来る対角成分 $\epsilon_{xx}$ にも大きく依存することを表している重要な式です。

•次のスライドで詳しい導き方を説明します。

## テーラー展開による近似

- (3.82)を導くにあたって、 $x$ が小さいとき成立する次の近似式を使いました。

$$\begin{aligned} \sqrt{1+x} &\approx 1 + x/2, \\ 1/(1+x) &\approx 1 - x, \\ (1+x)(1+y) &\approx 1 + x + y \\ \ln(1+x) &\approx x \end{aligned}$$

(3.82)

## 自習課題

(今回提出する必要はありません。)

- 式(3.81)から式(3.82)を導いてください。

$$\Phi_K \approx \frac{n_0 \epsilon_{xy}}{(n_0^2 - \epsilon_{xx}) \sqrt{\epsilon_{xx}}} \quad (3.82)$$

- 式(3.82)から式(3.83)を導いてください。

$$\begin{aligned} \theta_K &= n_0 \frac{n(n_0^2 - n^2 + 3\kappa^2)\epsilon'_{xy} + \kappa(n_0^2 - 3n^2 + \kappa^2)\epsilon''_{xy}}{(n^2 + \kappa^2)(n_0^2 - n^2 - \kappa^2)^2 + 4\kappa^2} \\ \eta_K &= n_0 \frac{-\kappa(n_0^2 - 3n^2 + \kappa^2)\epsilon'_{xy} + n(n_0^2 - n^2 + 3\kappa^2)\epsilon''_{xy}}{(n^2 + \kappa^2)(n_0^2 - n^2 - \kappa^2)^2 + 4\kappa^2} \end{aligned} \quad (3.83)$$

## 複素力一回転を誘電率で表す(3)

- 真空中から光が入射する場合、 $n_0=1$ として、下の式で書けます。

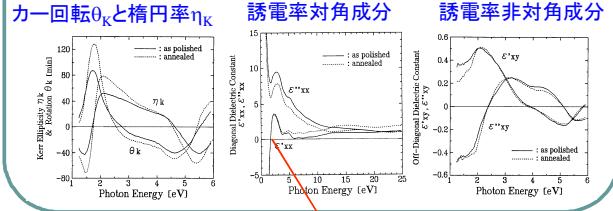
$$\theta_K = \frac{n(1-n^2+3\kappa^2)\epsilon'_{xy} + \kappa(1-3n^2+\kappa^2)\epsilon''_{xy}}{(n^2+\kappa^2)((1-n^2-\kappa^2)^2+4\kappa^2)} \quad (3.83')$$

$$\eta_K = \frac{-\kappa(1-3n^2+\kappa^2)\epsilon'_{xy} + n(1-n^2+3\kappa^2)\epsilon''_{xy}}{(n^2+\kappa^2)((1-n^2-\kappa^2)^2+4\kappa^2)}$$

## プラズマ・エンハンスメント

$$\Phi_K \approx \frac{\epsilon_{xy}}{(1-\epsilon_{xx})\sqrt{\epsilon_{xx}}}$$

- 今まで述べたように、複素力一回転角は誘電率の非対角成分だけでなく、対角成分にも関係します。
- プラズマ振動数においてエンハンス(増大)が起きます。
- 例: PtMnSb単結晶のカーリー回転スペクトルのピーク



出典: K.Sato et al: Proc. ICF6 (1992) p.1647 プラズマ振動数: 誘電率の実数部がゼロを横切る

## 斜め入射の極力一効果の式

- 入射角 $\phi_0$ で斜め入射した直線偏光の極力一複素回転角 $\Phi$ は、

$$\tan \Phi_K = \frac{r_{sp}}{r_{pp}} = \frac{\epsilon_{xy} \cos \phi_0}{\sqrt{\epsilon_{xx}} (\cos \phi_0 + \sqrt{\epsilon_{xx}} \cos \phi_2) (\cos \phi_2 - \sqrt{\epsilon_{xx}} \cos \phi_0)} \quad (3.88)$$

あらわすことができます。ここに $\phi_2$ は媒体内への屈折角です。

$\phi_0$ と $\phi_2$ との間にはスネルの法則が成立します。すなわち、

$$\frac{\sin \phi_0}{\sin \phi_2} = \frac{\sqrt{\epsilon_{xx}}}{n_0}$$

## 縦力一効果の式

- 入射角 $\phi_0$ で入射した直線偏光の受ける複素力一効果は、次式で表されます。

$$\tan \Phi_K = \frac{\epsilon_{xy} \cos \phi_0 \sin \phi_2}{\epsilon_{xx} (\sqrt{\epsilon_{xx}} \cos \phi_0 - \cos \phi_2) (\sqrt{\epsilon_{xx}} \cos \phi_2 + \cos \phi_0)} \quad (3.91)$$

$\phi_0$ と $\phi_2$ との間にはスネルの法則が成立します。すなわち、

$$\frac{\sin \phi_0}{\sin \phi_2} = \frac{\sqrt{\epsilon_{xx}}}{n_0}$$

## 第5回のまとめ

- 斜め反射の場合の反射率を屈折率、消光係数および入射角を用いて表しました。
- 反射率からクラマースクローニヒの式によって屈折率や消光係数が求められることを示しました。
- 反射の磁気光学効果である磁気力一効果が誘電率テンソルの対角・非対角成分で表されることを学びました。

## 第5回の課題

- 真空からある磁性体に光が垂直に入射する場合の、光強度の反射率 $R$ 、カーリー回転角 $\theta_K$ 、カーリー回転角率 $\eta_K$ を求めてください。ただし、この磁性体の誘電率の対角成分、非対角成分は、それぞれ、 $\epsilon_{xx}=6+2.5i$ ,  $\epsilon_{xy}=0.5-0.2i$ で与えられます。
- ヒント: 垂直入射の反射率 $R$ は、式(3.73)で与えられます。また、複素力一回転角 $\Phi_K=\theta_K+i\eta_K$ は、式(3.82)で表されます。なお、真空中からの入射なので $n_0=1$ です。
- なお、屈折率 $n$ と消光係数 $\kappa$ は、下式で計算できます。

$$n = \sqrt{\frac{|\epsilon_{xx}| + \epsilon'_{xx}}{2}}, \quad \kappa = \sqrt{\frac{|\epsilon_{xx}| - \epsilon'_{xx}}{2}} \quad \text{ここで} \quad |\epsilon| = \sqrt{\epsilon'^2_{xx} + \epsilon''^2_{xx}}$$